

「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に 向けた技術開発事業/ パワーエレクトロニクス関連動向調査|

~公募説明会~

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

2025年 2月7日

半導体・情報インフラ部

7

<目次>



- ・「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明
- ・ 今後のスケジュール
- ・質疑応答等

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 1/9



(1)調査

パワーエレクトロニクスの性能/機能の向上を支える**材料、技術及びシステムを俯瞰的に把握した上で、**将来発展するアプリケーションからの要求を抽出することで、グローバル市場における日本企業の優位点を見出し、**今後の日本のパワーエレクトロニクスが進むべき方向性を提示**する。

本調査は、定性的な情報整理に留まらず、**具体的なアクション、目標** 設定につながるように定量的な技術水準の特定までを実施すること。

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の 詳細説明 2/9



(2)調査対象

本調査では、2040 年から2050 頃までをターゲットにパワーエレクトロニクスを以下のレイヤーに分けて、技術動向等を調査する。アプリケーションの用途や耐圧性能への要求から、各レイヤーで必要とされる技術に違いが生じると考えられるので、アプリケーションの要求仕様を踏まえた整理を図るものとする。

- パワー半導体素材(Si、SiC、GaN、Ga₂O₃・AIN・Diamond等次世代材料)
 /ウエハ(バルク基板、貼合わせ基板、ヘテロ基板、エピ基板)/ウエハ加工技術(スライス、研磨など)
- パワー半導体デバイス (MOSFET、IGBTなど)
- パワーモジュール・実装技術・放熱技術・回路技術(周辺材料・部品含む) ※適宜、設計、製造プロセス、計測技術、評価技術、低コスト化技術、保守・メンテナンス技術等も含むこと。

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 3/9



▶ 主要分野・アプリケーション

対象とする主要分野・アプリケーションの例を以下に示す。**下線を引いた分野・アプリケーションは必須**とし、2040年から2050年頃までに実用化されると想定される有望なアプリケーションを協議の上で**20件程度選定**すること。

1つのアプリケーションで電圧、電流、スイッチング周波数が異なる複数のパワーエレクトロニクス機器を搭載する場合は各々について調査・分析すること。

- 電力系統インフラ (HVDC、スマートグリッド、STATCOM、SST、系統直接連系EV 急速充電器*)
 - *) AC6.6kV 等の高圧系統に直接接続し、商用周波数変圧器を用いない急速充電器
- <u>モビリティ</u> (xEV、車載充電器(OBC)、大型車(バス、トラック)、鉄道、 航空機、船舶、ドローン)
- ▶ 産業機器(電炉用電源、水電解装置、誘導加熱、建機、農機、レーザー加工機電源)
- ▶ データセンター(サーバー電源、UPS)
- ▶ その他調査で特定した主要アプリケーション(家庭・事務所蓄電池、医療機器、 特殊環境(耐放射線)など)

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 4/9



(3)調査内容

調査内容の基本は以下の項目立てとする(提案者による項目の追加、順序変更は 可)。

パワーエレクトロニクスに関わる国内外の企業・研究機関・アカデミア等について、その保有技術や開発動向/事業動向などについての情報を入手・整理し、今後取り組むべき方向性の分析を行う。

具体的には、以下の①パワーエレクトロニクス動向調査にてフォーキャスト型の網羅的な調査を行い、整理、分析する。その結果を踏まえて、今後日本が取り組むべき領域を特定するために以下の②今後我が国が取り組むべき領域の深掘り調査・分析・提言で示すバックキャスト型の深掘り調査を行う。

各調査の実施においては、適時、相談の上行うとともに、<u>専門家の意見も仰ぎな</u>がら実施することとする。

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 5/9



1パワーエレクトロニクス動向調査 (情報収集フェーズ)

- (2)で示した各レイヤーについてシーズベースで以下の動向調査を実施する。
- (ア) 市場動向調査 (売上、販売数、国別シェア、企業別シェア、コスト構造/動向、 環境インパクト、課題など)
- (イ)技術動向調査
- (ウ) **政策動向調査**(具体的なパッケージの内容、支援先、グリーン製造・カーボンフットプリントなど)
- (エ) (ア) ~ (ウ) に基づく**技術ロードマップ**の作成

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 6/9



② 今後我が国が取り組むべき領域の深掘り調査・分析・提言 (考察フェーズ)

本項目では、①パワーエレクトロニクス動向調査で網羅的に抽出した情報のうち、有識者等の意見等を踏まえながら複層的に整理、分析をし、2040 年から2050 年頃に日本企業がイニシアチブをとれる可能性があり、市場価値が高く、環境インパクトの大きい産業分野のアプリケーションを5 件程度選定し、当該アプリケーションからバックキャストして各レイヤーについて深掘り調査を行い、ロードマップや技術ベンチマークなどにまとめる。さらにグローバル市場における日本企業の競争戦略を可視化し、今後日本が取り組むべき領域を特定する。

その際、定性的な提言に留まらず、**目指すべき技術水準**や、達成した際の**環境への** インパクト(CO2 削減量など)も明らかとすること。

(ア)深堀り調査対象の特定

- (イ) (ア) で特定した領域におけるアプリケーションを軸にした**技術ロードマップ の作成**
 - ※①(エ)で抽出した技術ロードマップとの違いが取り組むべき領域の候補
- (ウ)技術ベンチマーク
- (工) 特許動向調査
- (オ) (ア) \sim (エ) に基づく**日本が取り組むべき内容の提言**

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 7/9



(3)調査方法

下記方法で情報収集を行い、収集した情報を整理・分析すること。 また、調査方法及びヒヤリング先は、NEDOと相談の上決定すること。

- ・公開情報による調査(各種レポート等、学術誌情報、学会参加等)
- ・ヒヤリング(有識者及び各技術を有する企業など80者程度を想定)
- ※提案時点で想定しているヒアリング候補などは、提案書に記載すること。

尚、調査の実施に当たっては、「**半導体・デジタル産業戦略の戦略的実行に向けた** 調査分析」を参考にしつつ行うこと。

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」の詳細説明 8/9



(4)中間まとめ、調査報告書

中間まとめ、調査報告書一式を、それぞれ以下の期日までに提出すること。

提出期限: 中間まとめ 2025 年 6 月上旬

調査報告書 2025 年12 月26 日 (金)

提出方法: 中間まとめ 別途NEDOの指定する方法

調査報告書 NEDO プロジェクトマネジメントシステムによる提出

記載内容: 中間まとめ 別途NEDOと相談して決定

※パワーエレクトロニクス動向調査について、電力インフラ、

モビリティ分野を優先して取りまとめること。

調査報告書 「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に

従うこと。

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

「パワーエレクトロニクス関連動向調査」



✓ 今後のスケジュール

·公募説明会: 2/7(金)···本日

・公募締切 : 2/28 (金) 予定

・採択通知 : 4/中 予定

・契約 : 5/末 予定

・調査期間 : NEDOの指定する日から、2025/12/26(金)まで

✓ 問い合わせ

本事業の内容に関するお問い合わせは、**2025年 1月28日から 2月26日の間**に以下の問い合わせ先にE-mail で受け付けます。

ただし、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

半導体・情報インフラ部 パワエレチーム

担当者:須田、小早川、徳丸、野村

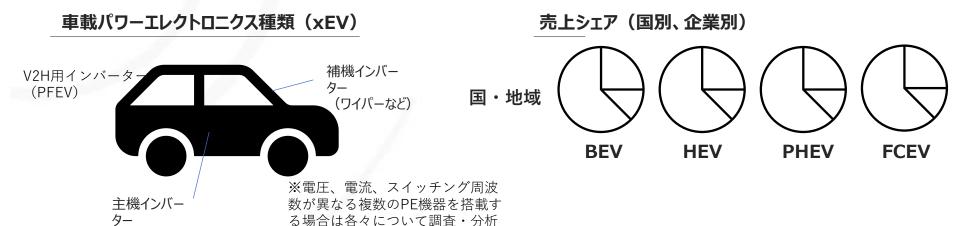
E-mail: power_el@nedo.go.jp



アウトプットイメージ

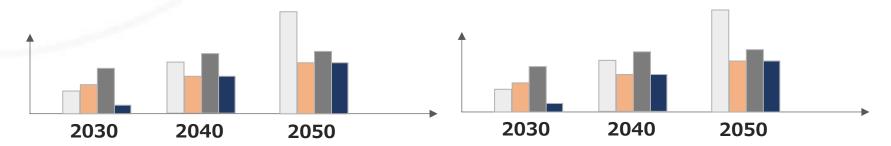


市場動向調査①



市場規模予測(BEV、 HEV、 PHEV、 FCEV)

市場規模予測(主機インバーター)

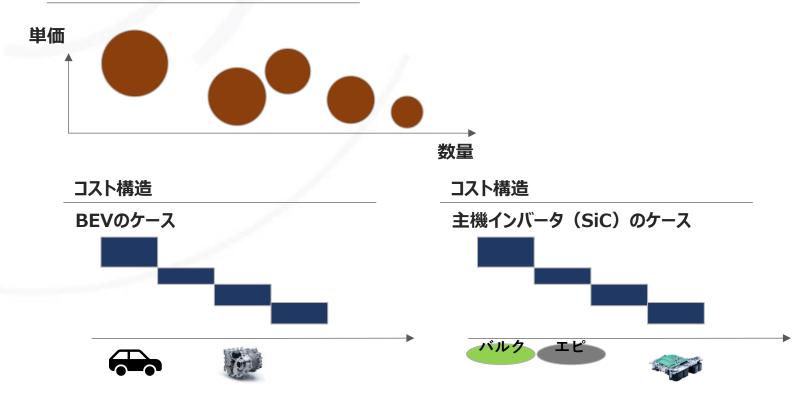


DC/DCチョッ



市場動向調査②

市場規模×数量(用途別)





市場動向調査③

環境インパクト



全産業に占める 排出割合 2050年にカーボンニュート ラル実現のためには、CO2削 減量が○○必要



市場動向調査④

モビリティの課題、ロードマップ



企業別の取り組み

| | 概要 | 戦略 | ラインナップ | 主な取引 |
|---------|----|----|--------|------|
| TOYOTA | | | | |
| (S) M A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



技術動向調査①

適用される技術(主機インタバーターの場合)

| システム | 素材 | デバイス | モジュール | 実装方法 | 放熱技術 |
|-----------------|----|------------|-------|------|------|
| 主機インバーター ○kV | | Si-IGBT | | | |
| | | SiC-MOSFET | | | |
| | | SiC-IGBT | | | |

各技術の詳細(技術内容、主なプレイヤー、開発状況)



技術動向調査②

企業別の取り組み(主機インバータの場合)

(ウエハ)

| | 概要 | 戦略 | ラインナップ | 主な取引 |
|----------|----|----|--------|------|
| Infineon | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



政策動向調査

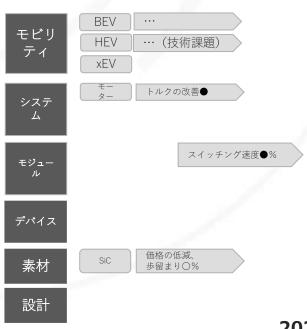
国別の取り組み(xEV関連PEプロジェクト)

| | プログラム名称 | 期間·予算 | 内容(目標) | 交付先 |
|------|---------|-------|--------|-----|
| | | | | |
| * | | | | |
| **** | | | | |



技術ロードマップ

解決すべき課題(次頁以降に詳細)



2030 2040 2050

アウトプットイメージ





特定した領域におけるアプリケーションを軸にした技術ロードマップ

| 電力系統インフラ | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|--------------|-------------------|------|------|----------|------|------|------|
| アプリ ケーション | HVDC | | | | | | |
| 機器 | 電力変換器 | | 200 | | | | |
| | ・実装技術 ・組立技術 | | 1 | | | | |
| モジュール | 圧接型モジュール | 1 | | | | | |
| | ・直並列回路技術 ・放熱技術 | | | | | | |
| | ・周辺材料/部品 | | | | | | |
| デバイス | Si-IGBT | | | | | | |
| | SiC-MOSFET | | | | | | |
| | SiC-IGBT | | | | | | |
| ウエハ | Siウエハ | | | | | | |
| | SiCウエハ | | | \ | | | |



国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構